## МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

## ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "РЯЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РАДИОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ В.Ф. УТКИНА"

СОГЛАСОВАНО Зав. выпускающей кафедры УТВЕРЖДАЮ Проректор по УР

А.В. Корячко

## Тонкопленочные структуры в электронике

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой Промышленной электроники

Учебный план 11.03.04\_23\_00.plx

11.03.04 Электроника и наноэлектроника

Квалификация бакалавр

Форма обучения очная

Общая трудоемкость 2 ЗЕТ

### Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр (<Курс>.<Семестр на курсе>)	8 (4	8 (4.2)		Итого	
Недель	8	3			
Вид занятий	УП	РΠ	УП	РΠ	
Лекции	16	16	16	16	
Лабораторные	16	16	16	16	
Иная контактная работа	0,25	0,25	0,25	0,25	
Итого ауд.	32,25	32,25	32,25	32,25	
Контактная работа	32,25	32,25	32,25	32,25	
Сам. работа	31	31	31	31	
Часы на контроль	8,75	8,75 8,75		8,75	
Итого	72	72	72	72	

УП: 11.03,04\_23\_00.plx cтр. 2

## Программу составил(и):

к.т.н., доц., Гололобов Геннадий Петрович

Рабочая программа дисциплины

### Тонкопленочные структуры в электронике

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

ФГОС ВО - бакалавриат по направлению подготовки 11.03.04 Электроника и наноэлектроника (приказ Минобрнауки России от 19.09.2017 г. № 927)

составлена на основании учебного плана:

11.03.04 Электроника и наноэлектроника

утвержденного учёным советом вуза от 28.04.2023 протокол № 11.

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

## Промышленной электроники

Протокол от 14.06.2023 г. № 12

Срок действия программы: 2023-2027 уч.г. Зав. кафедрой Круглов Сергей Александрович УП: 11.03.04\_23\_00.plx cтp. 3

# Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для исполнения в 2024-2025 учебном году на заседании кафедры Промышленной электроники Протокол от \_\_\_\_\_\_ 2024 г. № \_\_\_ Зав. кафедрой Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для исполнения в 2025-2026 учебном году на заседании кафедры Промышленной электроники Протокол от \_\_\_\_\_ 2025 г. № \_\_\_ Зав. кафедрой \_\_\_\_\_ Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для исполнения в 2026-2027 учебном году на заседании кафедры Промышленной электроники Протокол от \_\_\_\_\_\_ 2026 г. № \_\_\_ Зав. кафедрой \_\_\_\_\_

#### Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для исполнения в 2027-2028 учебном году на заседании кафедры

П	ромышленной	электі	мини
	<b>домышленной</b>	JUCKI	JUHHKH

Протокол от	_ 2027 г.	$N_{\underline{0}}$	_
Зав. кафедрой			

УП: 11.03.04\_23\_00.plx cтp. 4

	1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)						
	Целью освоения дисциплины «Тонкопленочные структуры в электронике» является формирование у будущих специалистов твердых теоретических знаний и практических навыков в части изучения основ электрохимических и физико-химических методов получения тонкопленочных структур металлов и сплавов применительно к химии, теоретической и прикладной электрохимии, материаловедению; в выработке умения выбрать оптимальную методику анализа и грамотно оценить полученный результат.						
1.2	Задачи дисциплины:						
	1) получение и закрепление теоретических и практических знаний в области физических и физико-химических явлений и процессов, лежащих в основе наиболее важных методов исследования состава, структуры и свойств материалов и покрытий и явлений в них;						
	2) понимание принципов работы и устройства типовых приборов и аппаратуры, используемых в данных методах, способов приготовления и подготовки образцов, обработки и анализа регистрируемых характеристик и источников возможных ошибок, определения точности экспериментов и их ограничений;						
1.5	3) приобретение знаний и навыков по оценке возможностей методов и их практическому использованию в						

получении тонкопленочных структур различной природы, изучению процессов и явлений в них.

2	2. МЕСТО ДИСЦИП	ЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ		
Цикл	(раздел) ОП:	Б1.В.ДВ.01		
2.1 Tp	ебования к предварі	ительной подготовке обучающегося:		
2.1.1 Ан	алитические приборы	и методы в электронике		
2.1.2 Ин	терфейсы и программ	пирование вычислительных систем		
2.1.3 Ha	учно-исследовательсь	кая практика		
2.1.4 Пр	ограммирование и сх	емотехника микропроцессорной техники		
2.1.5 Пр	оизводственная практ	тика		
2.1.6 Ци	фровая электроника			
2.1.7 Эл	ектронные и ионные і	приборы		
2.1.8 Эл	.8 Электронные цепи			
2.1.9 Cx	емотехника			
2.1.10 Ter	пловые процессы в эл	ектронике		
2.1.11 Tex	хнологическая (проек	тно-технологическая)		
2.1.12 Tex	хнология изделий мин	сро- и наноэлектроники		
2.1.13 Эл	ектромагнитные поля	и волны. Ч.2		
2.1.14 Тве	ердотельная электрон	ика		
2.1.15 Tex	хнологические процес	сы наноэлектроники		
2.1.16 Ци	фровая обработка сиг	налов в электронных устройствах		
1 '	сциплины (модули) едшествующее:	и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как		

## 3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

ПК-2: Способен анализировать, систематизировать и обобщать результаты исследований приборов, схем, устройств и установок электроники и наноэлектроники различного функционального назначения

### ПК-2.1. Анализирует научные данные, результаты экспериментов и наблюдений

#### Знать

Основные методы и средства проведения экспериментальных исследований, системы стандартизации и сертификации.

#### Уметь

Выбирать способы и средства измерений и проводить экспериментальные исследования.

## Владеть

Способами обработки и представления полученных данных и оценки погрешности результатов измерений.

ПК-2.2. Систематизирует и обобщает результаты исследований приборов, схем, устройств и установок электроники и наноэлектроники различного функционального назначения, представляет материалы в виде научных отчетов, публикаций, презентаций

УП: 11.03.04 23 00.plx cтр.

#### Знать

Принципы работы по технологической подготовке производства материалов и изделий электронной техники.

#### Уметь

Выполнять работы по технологической подготовке производства материалов и изделий электронной техники.

Проектировать тонкопленочные и полупроводниковые микросхемы и представлять отчеты по результатам исследований. Владеть

Навыками выполнения работ по технологической подготовке производства материалов и изделий электронной техники.

## ПК-3: Способен разрабатывать и анализировать технологические процессы изготовления устройств и установок электроники и наноэлектроники различного функционального назначения

## ПК-3.2. Проводит анализ технических требований, предъявляемых к изделиям электроники и наноэлектроники различного функционального назначения

#### Знать

Методы осаждения тонких пленок, процессы роста тонкопленочных покрытий.

#### Уметь

Проводить необходимые эксперименты, получать результаты, обрабатывать и анализировать их в рамках метода.

#### Владеть

Методами количественного структурного анализа, контроля качества и определения характеристик материалов и покрытий, а также основами сертификации материалов и покрытий.

## В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен

3.1	Знать:					
3.1.1	Основные понятия технологии плёночных изделий в электронике;					
3.1.2	Методы осаждения тонких пленок, процессы роста тонкопленочных покрытий;					
3.1.3	.3 Область применения плёнок и плёночных структур в электронике; требования к контактным покрытиям;					
3.1.4	Методы и технологии формирования рисунка интегральных микросхем;					
3.1.5	Методы придания плёнкам требуемых свойств.					
3.2	Уметь:					
3.2.1	Составлять технологический маршрут изготовления тонкопленочных и полупроводниковых микросхем;					
3.2.2	Проводить необходимые эксперименты, получать результаты, обрабатывать и анализировать их в рамках метода;					
3.2.3	Подбирать материалы по их назначению и условиям эксплуатации для выполнения работ;					
3.2.4	Эксплуатировать контрольно-измерительное измерительное оборудование для измерения параметров и характеристик материалов для производства изделий электроники;					
3.2.5	Оценивать поведение материала и причины отказов устройств электроники при воздействии на них различных эксплуатационных факторов: обоснованно выбирать материал и при необходимости его обработку для получения необходимой структуры и свойств, обеспечивающих высокую надежность и долговечность элементов электронной техники.					
3.3	Владеть:					
3.3.1	С методами количественного структурного анализа, контроля качества и определения характеристик материалов и покрытий, а также основами сертификации материалов и покрытий;					
3.3.2	С навыками представления результатов исследования в форме научных отчетов, публикаций, презентаций.					

	4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)						
Код занятия	Наименование разделов и тем /вид занятия/	Семестр / Курс	Часов	Компетен- пии	Литература	Форма контроля	
	Раздел 1. Основные понятия технологии плёночных изделий.						
1.1	Этапы развития и направления современной электроники. /Тема/	8	0				
1.2	Лекция 1 /Лек/	8	2	ПК-2.1-У	Л1.6 Л1.5Л2.4Л3.1 Э1 Э3		
1.3	Применение плёнок и плёночных структур в электронике. Этапы разработки и изготовления плёночных изделий. /Тема/	8	0				
1.4	Лекция 2 /Лек/	8	2	ПК-2.1-У ПК-2.1-В ПК-3.2-3	Л1.6 Л1.5Л2.3 Л2.2Л3.1 Л3.1 Э1 Э3		

УП: 11.03.04\_23\_00.plx cтр. 6

	Раздел 2. Методы нанесения пленок и покрытий.					
2.1	Катодное распыление. Механизм катодного распыления. Конденсация материала при катодном распылении. /Тема/	8	0			
2.2	Лекция 1 /Лек/	8	2	ПК-2.1-В ПК-2.2-У ПК-3.2-3	ЛЗ.1 Л1.1Л1.5ЛЗ.1 Э2	
2.3	Лабораторная работа 1 /Лаб/	8	4	ПК-2.1-В	Л1.4Л1.5Л3.1 Э4	
2.4	Нанесение плёнок методом электрического взрыва вещества. /Тема/	8	0			
2.5	Лекция 2 /Лек/	8	2	ПК-2.1-В	Л3.1 Л1.1Л1.4 Л3.1Л1.5 Л2.3 ЭЗ Э5	
2.6	Лабораторная работа 2 /Лаб/	8	4	ПК-2.1-В ПК-2.2-У ПК-3.2-3	Л1.6Л3.1 Л3.1Л1.5 Э2 Э4	
2.7	Гальваническое нанесение плёнок. Химическое осаждение в электролитах. /Тема/	8	0			
2.8	Лекция 3 /Лек/	8	2	ПК-2.1-В ПК-3.2-3	Л3.1Л1.4Л1.1 Э1 Э5	
2.9	Лабораторная работа 2 /Лаб/	8	4	ПК-2.1-В ПК-2.2-У	Л1.6Л1.1Л1.5 ЭЗ Э4	
2.10	Плазмохимические методы нанесения плёнок. Способы нанесения и формирования наноструктур. /Тема/	8	0			
2.11	Самостоятельная работа /Ср/	8	8	ПК-2.1-У ПК-2.1-В ПК-2.2-У ПК-3.2-3	Л1.6Л3.1Л3.1 Э3	
	Раздел 3. Функциональные материалы и покрытия в электронике.					
3.1	Газопоглотительные покрытия и материалы. Электроизоляционные покрытия. /Тема/	8	0			
3.2	Лекция 1 /Лек/	8	2	ПК-2.1-У	Л1.6Л3.1Л1.1 Э1	
3.3	Эрозионно-стойкие покрытия электродов. Покрытия с высоким коэффициентом ион- электронной эмиссии. /Тема/	8	0			
3.4	Лекция 2 /Лек/	8	2	ПК-3.2-3	Л3.1Л1.5Л2.4 Э2 Э4	
3.5	Лабораторная работа 1 /Лаб/	8	4	ПК-2.2-У	Л1.6Л3.1Л2.4 Э3	
3.6	Контактные покрытия магнитоуправляемых контактов. Требования к контактным покрытиям (структура, фазовый состав, физикомеханические и другие свойства). Технологии нанесения контактных покрытий. /Тема/	8	0			
3.7	Лекция 3 /Лек/	8	2	ПК-2.1-В ПК-3.2-3	Л1.5Л3.1Л2.4 ЭЗ Э4	
3.8	Контрольная работа /Зачёт/	8	3,75	ПК-2.1-В	Л1.4Л3.1Л2.4 Э4	

УП: 11.03.04\_23\_00.plx cтр. <sup>\*</sup>

3.9	Покрытия на основе золота. Многослойные	8	0			
	покрытия. Барьерные слои. /Тема/					
3.10	Самостоятельная работа /Ср/	8	6	ПК-2.1-В ПК-3.2-3	Л1.1Л1.4Л3.1 Э2	
	Раздел 4. Тонкопленочные фотоэлементы.					
4.1	Фотоэлементы на основе кристаллических пленок кремния. /Тема/	8	0			
4.2	Самостоятельная работа /Ср/	8	4	ПК-2.1-У ПК-2.1-В ПК-3.2-3	Л1.1Л2.4Л3.1 Э3	
4.3	Технологический процесс изготовления тонкопленочных фотоэлементов. Просветление тонкопленочных	8	0			
4.4	Самостоятельная работа /Ср/	8	4	ПК-2.1-В ПК-2.2-У ПК-3.2-3	Л1.2Л2.4Л1.5 Э2	
	Раздел 5. Получение рисунка интегральных схем.					
5.1	Фотолитография. Способы экспонирования. /Тема/	8	0			
5.2	Самостоятельная работа /Ср/	8	4	ПК-2.1-У ПК-2.2-У	Л1.2Л1.1Л1.6 Э4 Э5	
5.3	Контрольная работа /Зачёт/	8	5	ПК-2.1-У ПК-2.1-В	Л1.2Л1.1Л1.5 Э2	
5.4	Оптические эффекты при фотолитографии. Методы и технология формирования рисунка интегральных микросхем. /Тема/	8	0			
5.5	Самостоятельная работа /Ср/	8	5	ПК-2.1-В ПК-2.2-У	Л1.2Л1.1Л1.4 Э2	
5.6	Контактная работа /ИКР/	8	0,25	ПК-2.1-У ПК-2.1-В ПК-2.2-У	Л1.6Л1.4Л1.1 Э4	

## 5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Оценочные материалы приведены в приложении к рабочей программе дисциплины (см. документ «Оценочные материалы по дисциплине «Тонкопленочные структуры в электронике»)

6.	6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)						
	6.1. Рекомендуемая литература						
		6.1.1. Основная литература					
No	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Количество/ название ЭБС			
Л1.1	Васильев, В. Ю.	Технология тонких пленок для микро- и наноэлектроники : учебное пособие	Новосибирски й государственн ый технический	https://www.ip			

УП: 11.03.04\_23\_00.plx cтр. 8

Л1.2			год	название ЭБС
	Антоненко С. В.	Технология тонких пленок: учебное пособие для вузов	Москва: НИЯУ МИФИ, 2008, 104 с.	978-5-7262- 1036-0, http://e.lanboo k.com/books/e lement.php? pl1_id=75918
]	Перелыгин А.И., Маслов А.А., Туркин Ю.А.	Конструкции ИМС и технология тонких пленок : Метод.указ.к лаб.работам	Рязань, 1997, 36c.	, 1
Л1.4	Чижиков А.Е.	Физические основы электронной техники: Метод.указ.к практ.занятиям	Рязань, 1995, 20c.	, 1
Л1.5	Чижиков А.Е.	Основы технологии электронной компонентной базы : Методические указания	Рязань: РИЦ РГРТУ, 2018,	, https://elib.rsre u.ru/ebs/downl oad/1844
Л1.6	Чижиков А.Е.	Физические основы электронной техники и технологии : Методические указания	Рязань: РИЦ РГРТУ, 2000,	https://elib.rsre u.ru/ebs/downl oad/1273
		6.1.2. Дополнительная литература	<u>"</u>	
No	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Количество/ название ЭБС
:	Шик А.Я., Бакуева Л.Г., Мусихин С.Ф., Рыков С.А.	Физика низкоразмерных систем: Учеб.пособие	СПб.:Наука, 2001, 155с.	5-02-024966- 1, 1
Л2.2	Чижиков А.Е.	Исследование и разработка путей повышения качества газоразрядных индикаторных панелей: Автореферат	Рязань, 1999, 38c.	, 1
]	Коротченко В.А., Молчанов Ю.К., Соломенникова В.С., Чижиков А.Е.	Технология материалов и изделий электронной техники: Методические указания	Рязань: РИЦ РГРТУ, 2016,	, https://elib.rsre u.ru/ebs/downl oad/2271
		6.1.3. Методические разработки	•	
№	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Количество/ название ЭБС

УП: 11.03.04\_23\_00.plx cтр. 9

	1		7	1
№	Авторы, составители	Заглавие	Издательство,	Количество/
			год	название ЭБС
Л3.1	Амиров И. И.,	Нанотехнологии в электронике-3.1	Москва:	978-5-94836-
	Артамонова Е. А.,		Техносфера,	423-0,
	Балашов А. Г.,		2016, 480 c.	http://www.ipr
	Бардушкин В. В., Белов			bookshop.ru/5
	А. Н., Беспалов В. А.,			8864.html
	Бобринецкий И. И.,			
	Боргардт Н. И., Вернер			
	В. Д., Волков Р. Л., Гаврилов С. А.,			
	Галперин В. А.,			
	Герасименко А. Ю.,			
	Голишников А. А.,			
	Горбацевич А. А.,			
	Громов Д. Г., Дюжев Н.			
	А., Егоркин В. И.,			
	Звездин А. К.,			
	Земляков В. Е., Кицюк			
	Е. П., Ключников А. С., Красников Г. Я.,			
	Красников Г. Л., Красноков А. С.,			
	Крупкина Т. Ю.,			
	Кузнецов А. Е., Лавров			
	И. В., Лебедев Е. А.,			
	Лукичев В. Ф.,			
	Мазуркин Н. С.,			
	Морозов Р. А.,			
	Неволин В. К., Плис В. И., Плохов Д. И.,			
	Подгаецкий В. М.,			
	Попков А. Ф., Попов А.			
	И., Путря М. Г., Рощин			
	В. М., Румянцев А. В.,			
	Савельев М. С., Сауров			
	А. Н., Светличный В.			
	А., Селищев С. В.,			
	Силибин М. В., Солнышкин А. В.,			
	Стемпковский А. Л.,			
	Терещенко С. А.,			
	Тимошенков В. П.,			
	Тимошенков С. П.,			
	Чаплыгин Е. Ю.,			
	Чаплыгин Ю. А.,			
	Чиненков М. Ю.,			
	Шевяков В. И., Юров А. С., Яковлев В. Б.,			
	А. С., яковлев В. Б., Яковлева Е. Н.,			
	Чаплыгин Ю. А.			
Л3.2	Неволин В.К.	Зондовые нанотехнологии в электронике	М.:Техносфера,	5-94836-054-
			2005, 152c.	7, 1
Л3.3	РРТИ;Науч.рук.Чижи	Создание состава и методов активирования	Рязань, 1989,	, 1
	ков А.ЕТема N 16-	толстопленочного эмиссионного покрытия катодов	144c.	
	88;N ГР	газоразрядных индикаторов : Отчет о НИР (Закл.)		
	У52770/8003164;Инв.			
	N T58229			

УП: 11.03.04\_23\_00.plx cтp. 10

№	Авторы, составители	Заглавие	Издательство,	Количество/		
			год	название ЭБС		
Л3.4	Под ред. Чаплыгина	Нанотехнологии в электронике	1 1 /	5-94836-059-		
	Ю.А.		2005, 448c.	8, 1		
6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"						
Э1	Сайт кафедры промышленной электроники РГРТУ					
Э2	Система дистанционного обучения РГРТУ					
Э3	Информационная образовательная среда РГРТУ					
Э4	Электронно-библиотечная система «IPRbooks»					
Э5	Электронно-библиотечная система издательства «Лань»					
	(2.11					

### 6.3 Перечень программного обеспечения и информационных справочных систем

## 6.3.1 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •					
Наименование		Описание			
Операционная система Windows		Коммерческая лицензия			
Adobe Acrobat Reader		Свободное ПО			
LibreOffice		Свободное ПО			
Академическая версия пакета LabVIEW 2009		Свободное ПО			
Micro-Cap 12		Свободное ПО			
MathCAD		Коммерческая лицензия			
6.3.2 Перечень информационных справочных систем					
6.3.2.1	Система КонсультантПлюс http://www.consultant.ru				
6.3.2.2	Информационно-правовой портал ГАРАНТ.РУ http://www.garant.ru				

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)						
1	209 лабораторный корпус. помещение для самостоятельной работы обучающихся, компьютерный клас Специализированная мебель (21 посадочных места), магнитно-маркерная доска. Мультимедиа проектор, 1 экран ПК. Возможность подключения к сети Интернет и обеспечением доступа в электронную информационно образовательную среду РГРТУ					
2	214 лабораторный корпус. учебная аудитория для проведения учебных занятий. Специализированная мебель (60 посадочных мест), магнитно-маркерная доска. Мультимедиа проектор, 1 экран. ПК.					

## 8. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Методическое обеспечение дисциплины приведено в приложении к рабочей программе дисциплины (см. документ «Методические указания дисциплины «Тонкопленочные структуры в электронике»)

		Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"		
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН	ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ			
ПОДПИСАНО ЗАВЕДУЮЩИМ КАФЕДРЫ	<b>ФГБОУ ВО "РГРТУ", РГРТУ,</b> Круглов Сергей Александрович, Заведующий кафедрой ПЭЛ	<b>27.09.23</b> 11:45 (MSK)	Простая подпись	
ПОДПИСАНО ЗАВЕДУЮЩИМ ВЫПУСКАЮЩЕЙ КАФЕДРЫ	<b>ФГБОУ ВО "РГРТУ", РГРТУ,</b> Круглов Сергей Александрович, Заведующий кафедрой ПЭЛ	<b>27.09.23</b> 11:46 (MSK)	Простая подпись	
ПОДПИСАНО ПРОРЕКТОРОМ ПО УР	<b>ФГБОУ ВО "РГРТУ", РГРТУ,</b> Круглов Сергей Александрович, Заведующий кафедрой ПЭЛ	<b>27.09.23</b> 11:46 (MSK)	Простая подпись	
	<b>ФГБОУ ВО "РГРТУ", РГРТУ,</b> Корячко Алексей Вячеславович, Проректор по учебной работе	<b>27.09.23</b> 13:21 (MSK)	Простая подпись	